

Silicon Fast Recovery Diode

$V_{RRM} = 800\text{ V} - 1000\text{ V}$

$I_F = 12\text{ A}$

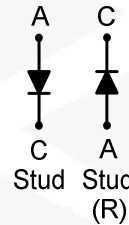
Features

- High Surge Capability
- Types from 800 V to 1000 V V_{RRM}
- Not ESD Sensitive

Note:

1. Standard polarity: Stud is cathode.
2. Reverse polarity (R): Stud is anode.
3. Stud is base.

DO-4 Package



Maximum ratings, at $T_j = 25\text{ °C}$, unless otherwise specified ("R" devices have leads reversed)

Parameter	Symbol	Conditions	FR12K(R)05	FR12M(R)05	Unit
Repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}		800	1000	V
RMS reverse voltage	V_{RMS}		560	700	V
DC blocking voltage	V_{DC}		800	1000	V
Continuous forward current	I_F	$T_C \leq 100\text{ °C}$	12	12	A
Surge non-repetitive forward current, Half Sine Wave	$I_{F,SM}$	$T_C = 25\text{ °C}$, $t_p = 8.3\text{ ms}$	180	180	A
Operating temperature	T_j		-55 to 150	-55 to 150	°C
Storage temperature	T_{stg}		-55 to 150	-55 to 150	°C

Electrical characteristics, at $T_j = 25\text{ °C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Conditions	FR12K(R)05	FR12M(R)05	Unit
Diode forward voltage	V_F	$I_F = 12\text{ A}$, $T_j = 25\text{ °C}$	0.8	0.8	V
Reverse current	I_R	$V_R = 100\text{ V}$, $T_j = 25\text{ °C}$	25	25	μA
		$V_R = 100\text{ V}$, $T_j = 150\text{ °C}$	6	6	mA

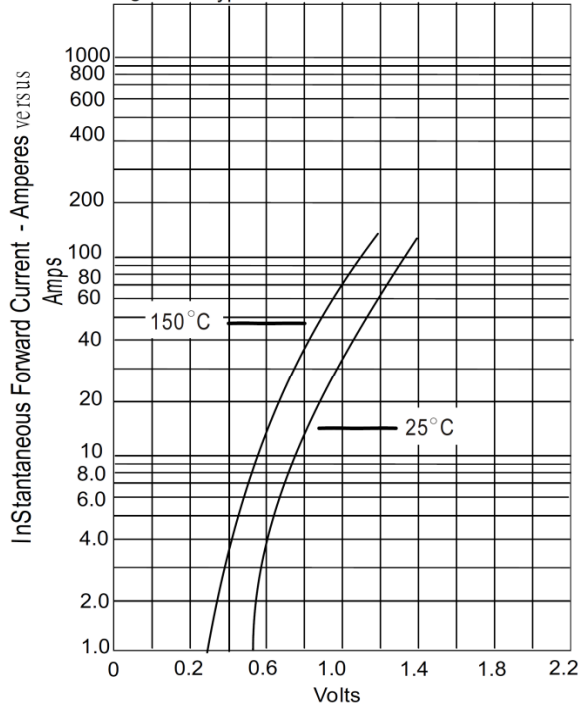
Recovery Time

Maximum reverse recovery time	T_{RR}	$I_F = 0.5\text{ A}$, $I_R = 1.0\text{ A}$, $I_{RR} = 0.25\text{ A}$	500	500	nS
-------------------------------	----------	---	-----	-----	----

Thermal characteristics

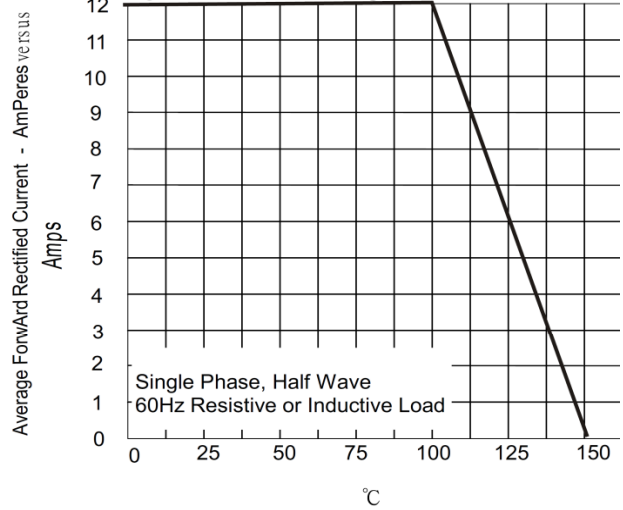
Thermal resistance, junction - case	R_{thJC}		2.0	2.0	°C/W
-------------------------------------	------------	--	-----	-----	------

Figure .1-Typical Forward Characteristics



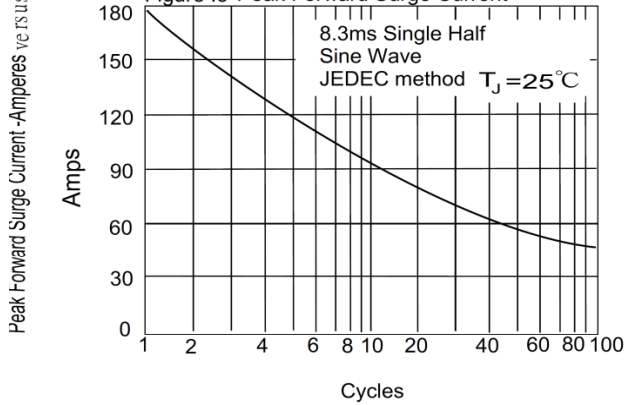
Instantaneous Forward Voltage - Volts

Figure .2-Forward Derating Curve



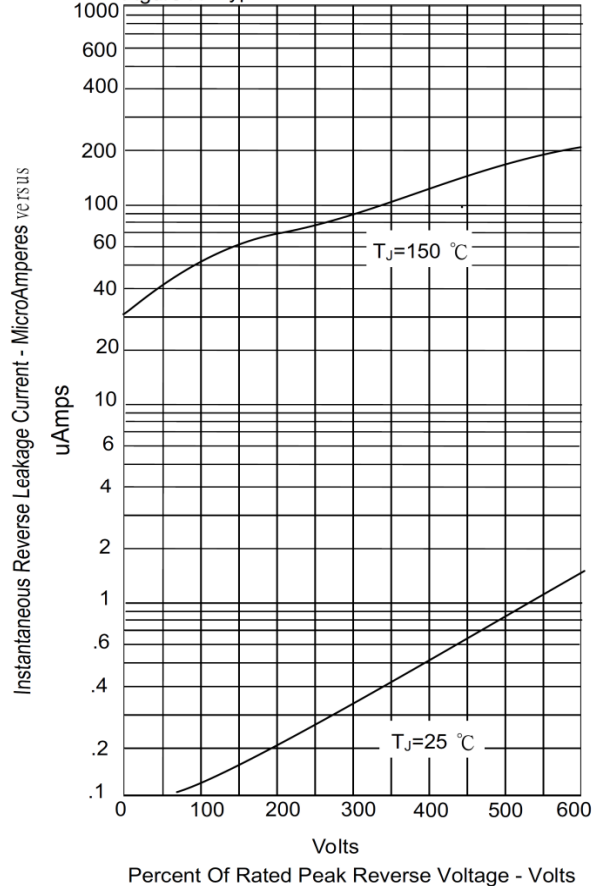
Case Temperature - °C

Figure .3-Peak Forward Surge Current



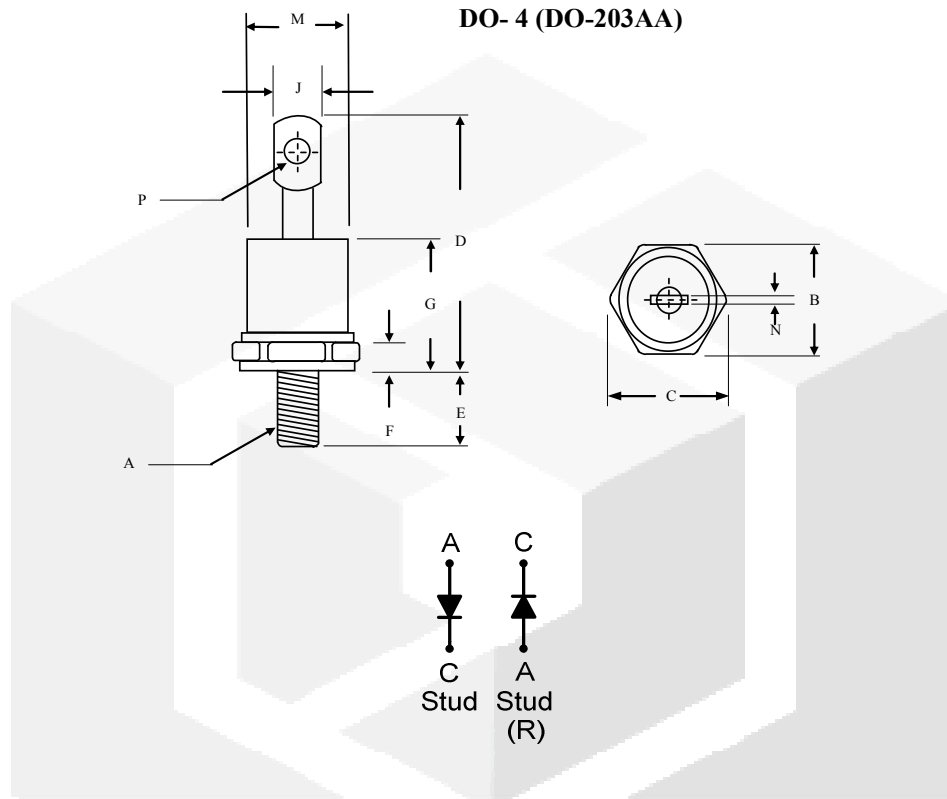
Number Of Cycles At 60Hz - Cycles

Figure .4- Typical Reverse Characteristics



Package dimensions and terminal configuration

Product is marked with part number and terminal configuration.



	Inches		Millimeters	
	Min	Max	Min	Max
A	10-32 UNF			
B	0.424	0.437	10.77	11.10
C	----	0.505	----	12.82
D	-----	0.800	----	20.30
E	0.453	0.492	11.50	12.50
F	0.114	0.140	2.90	3.50
G	----	0.405	----	10.29
J	----	0.216	----	5.50
M	----	φ0.302	----	φ7.68
N	0.031	0.045	0.80	1.15
P	0.070	0.79	1.80	2.00



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.